

特許協力条約

発信人 日本国特許庁（国際調査機関）



出願人代理人
藤村 元彦

様

あて名

〒 104-0045
東京都中央区築地4丁目1番17号
銀座大野ビル
藤村国際特許事務所

PCT
国際調査機関の見解書
(法施行規則第40条の2)
[PCT規則43の2.1]

発送日
(日.月.年)

16.11.2004

出願人又は代理人
の書類記号 PCT01-03084

今後の手続きについては、下記2を参照すること。

国際出願番号
PCT/J P 2004/009790

国際出願日
(日.月.年) 02.07.2004

優先日
(日.月.年) 07.07.2003

国際特許分類 (IPC) Int. Cl. H05B33/26

出願人 (氏名又は名称)
バイオニア株式会社

1. この見解書は次の内容を含む。

- ☒ 第I欄 見解の基礎
- ☐ 第II欄 優先権
- ☐ 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
- ☐ 第IV欄 発明の単一性の欠如
- ☒ 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- ☐ 第VI欄 ある種の引用文献
- ☐ 第VII欄 国際出願の不備
- ☐ 第VIII欄 国際出願に対する意見

2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日

29.10.2004

名称及びあて先
日本国特許庁 (ISA/J P)
郵便番号 100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)
里村 利光

2 V 9 3 1 4

電話番号 03-3581-1101 内線 3271

様式PCT/ISA/237 (表紙) (2004年1月)

第 I 欄 見解の基礎

1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。

- ☐ この見解書は、_____ 語による翻訳文を基礎として作成した。
それは国際調査のために提出された PCT 規則 12.3 及び 23.1(b) にいう翻訳文の言語である。

2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、以下に基づき見解書を作成した。

- a. タイプ ☐ 配列表
☐ 配列表に関連するテーブル
- b. フォーマット ☐ 書面
☐ コンピュータ読み取り可能な形式
- c. 提出時期 ☐ 出願時の国際出願に含まれる
☐ この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された
☐ 出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された

3. ☐ さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

4. 補足意見：

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、
それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲 8, 12, 14, 16-23	有 無
	請求の範囲 1-7, 9-11, 13, 15	
進歩性 (IS)	請求の範囲 17-23	有 無
	請求の範囲 1-16	
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 1-23	有 無
	請求の範囲	

2. 文献及び説明

文献1: JP 61-151996 A (株式会社日立製作所)
1986. 07. 10

文献2: JP 02-162684 A (株式会社小松製作所)
1990. 06. 22,

文献3: JP 2001-506393 A (フィリップスエレクトロニクスネム
ローゼフェンノートシャップ) 2001. 05. 15, 請求項6乃至7

請求の範囲17乃至23について

導電性を有する共通層に対して、高抵抗化工程を施した後、更に低抵抗化工程を
施す点は、先行技術文献のいずれにも記載がないから、本願発明は自明でない。

請求の範囲1乃至6、9-10について

上記文献1. の請求項1には、絶縁性基板上に形成された導電膜の電極として不
必要な部分を選択的に酸化して絶縁化させることによって、透明電極パターン相互
間に絶縁膜を形成する薄膜EL素子の製造方法が記載されている。

さらに、同文献には、上記絶縁化処理として、酸化性雰囲気中で加熱処理するこ
と(請求項3)、溶媒中で陽極酸化処理すること(請求項4)、酸素イオン打込み
を行うこと(請求項5)等の方法が記載されている。

したがって、本願発明は上記文献1. に記載された事項に基づき新規性及び進歩
性を有しない。

請求の範囲8、12、16について

上記文献1には、薄膜EL素子の導電膜の材料として酸化インジウムまたはIT
O等の金属酸化物が記載されている。

そして、該金属酸化物が結晶性を有し、結晶性の度合(結晶粒界の多少)によっ
て比抵抗が変化することは技術常識である。

したがって、上記文献1. に記載された絶縁化工程において、導電膜の所望の部
分の結晶性を変化させて導電性に分布を付与する程度のことは、当業者であれば容
易に想到し得たことである。

補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

第 V 欄の続き

請求の範囲 7、13、15 について

上記文献 2 の第 2 頁右上欄～左下欄には、透光性基板 10 に形成された絶縁性金属酸化物膜 12 の電極になる部分のみに、マスクを使って A 1 等の金属層 12 を形成し、該基板をアニールして前記金属層の金属を前記絶縁性金属酸化物の中に拡散させて透明電極 13 を形成する点が記載されている。

したがって、本願発明は上記記載に基づいて新規性及び進歩性を有しない。

請求の範囲 14 について

上記文献 2 に記載されているように、電極間に高抵抗化領域を形成する方法において、導電層を形成した後、電極相当領域を低抵抗化する手法は公知である。

一方、既に指摘したとおり、電極以外の領域を高抵抗化する手法として、当該領域を酸化させる手法も文献 1 によって公知である。

したがって、導電層を形成した後、電極相当領域を低抵抗化する際に、当該領域を還元する程度のことは当業者であれば容易に想到し得ることである。

請求の範囲 11 について

上記文献 3 の請求項 7、及び第 10 頁～11 頁には、PEDOT からなる電極層にあるパターンを有する輻射線を露光し、該電極上に電気絶縁パターンを形成する EL 装置の製造方法が記載されている。

したがって、本願発明は上記記載に基づき新規性及び進歩性を有しない。